

日本表面真空学会中部支部 4 月講演会

表面界面と半導体デバイス

日本表面真空学会中部支部 支部長 河原敏男

半導体デバイスの研究開発において、産学が連携して常に最新の表面真空技術が駆使されることで、発展が続いてきたことは周知のことと思います。日本表面真空学会も合併して1年ほどが過ぎ、2019年度の中中部支部の総会後には下に示すように半導体デバイス研究を牽引されてきた三人の先生方にご講演をお願いしました。もうすぐ、元号も平成から次に移り変わるこの機会に、昔を振り返るとともに将来の半導体デバイスやその周辺も見据えたご講演をいただけることは真に喜ばしく思います。新年度を迎え、本講演会にぜひとも奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

主催：日本表面真空学会中部支部

協賛(予定)：応用物理学会東海支部

日時：平成 31 年 4 月 27 日(土) 13:45～17:00

会場：名古屋工業大学 2 号館 2 階 0221 (I 1) 教室

(〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町；<https://www.nitech.ac.jp/access/index.html>)

参加費：(当日会場にてお支払いください)

日本表面真空学会会員	無料	参加申し込み時に、懇親会への出欠をご連絡 ください。
協賛学会会員	無料	
非会員	2,000 円	
学 生	無料	
懇親会	4,000 円 (予定)	

申し込み・問い合わせ先

申し込み締め切り：4 月 19 日 (金)

庶務担当 小川大輔 (E-mail: d_ogawa@isc.chubu.ac.jp)

プログラム

- 13:45～14:45 「産学連携と GaN 研究コンソシアム」
名古屋大学未来社会創造機構 財満鎮明 先生
- 14:45～15:45 「エネルギー変換材料・デバイスの研究開発」
静岡大学イノベーション社会連携推進機構 村上健司 先生
- 16:00～17:00 「Ge CMOS の実現に向けて理解すべきいくつかの古くて新しくてそして面白いこと」
東京大学工学系研究科 鳥海明 先生
- 17:30～ 懇親会